

Cd_{1-x}Sm_xTe 光学和磁性质的研究*

陈辰嘉 瞿 明 史守旭 唐晓东

(北京大学物理系, 北京, 100871)

马 可 军

(中国科学院上海技术物理研究所, 上海, 200083)

用改进的 Bridgman 方法首次生长了 Cd_{1-x}Sm_xTe ($x=0.0005, 0.005, 0.01, 0.05$) 晶体。用光荧光方法测量了样品在液氮下的光致发光谱，并用提拉法在温度 1.5 K 下、磁场强度直到 7 T 范围测量了磁化强度。实验表明随着标称组份的增加，发光峰向短波方向移动，与晶格常数变小趋势相对应。讨论与分析稀土元素离子与过渡族元素离子的磁性差别。

关键词：稀土离子，光致发光，磁化，碲镉铋(Cd Sm Te)。

1 引 言

半磁半导体(SMSC)或稀释磁性半导体(DMSO)是一类新型的半导体材料。近年来对典型的 SMSO 如 Cd_{1-x}Mn_xTe、Hg_{1-x}Mn_xTe 等材料已有大量研究，顺磁离子 Mn⁺⁺ 在这些化合物中起到重要作用，它控制化合物的能隙，同时还保持 3d 电子态的某些特性。由于局域顺磁离子与迁移载流子之间的自旋交换作用，使 SMSO 在低温和外磁场下显示出许多异常特性^[1]，引起广泛的关注。为了开拓含稀土离子的 SMSO 材料，我们尝试了含具有 4f 电子态特性 Sm 的 Cd_{1-x}Sm_xTe 单晶的生长和特性研究。本文着重报道用光致发光谱方法研究 Cd_{1-x}Sm_xTe 的特性，同时在低温、强磁场下测量磁化强度，以研究其磁性。分析讨论了 Sm 离子在晶体中的作用。

2 稀土元素离子的顺磁性

稀土族元素离子的 SMSO 与通常研究得最多的含过渡族元素离子的 SMSO 的特性^[2]有很大差别，首先是电子组态的差异。过渡族离子未满壳层电子为 3d 态，而 3d 壳层电子靠近最外壳层，受近邻核点的核和电子库仑作用的影响颇大。这些元素与其它元素形成晶体时，由于强晶场(非均匀电场)的作用使电子自旋与轨道耦合解脱，这时电子轨道态能量简并完全解

本文 1990 年 7 月 2 日收到。

* 国家自然科学基金资助课题。

除, 总角动量量子数 J 不再表征这些能态, 形成电子轨道角动量冻结(或称轨道角动量猝灭), 平均轨道角动量为零。这时过渡族元素离子处于 $L=0$ 态, 其磁性与轨道角动量无关, 而主要来源于电子的自旋磁矩。通常可通过引入自旋在磁场方向的热平均值 $\langle S_z \rangle$ 正比于宏观体磁化强度 M 来描述局域顺磁离子与迁移载流子间的自旋交换作用。例如过渡族元素 Mn^{++} 离子, 其电子组态为 $3d^5$, 最外层电子为半满, 自旋取 $(\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow)$ 态, 则自旋量子数 $S=5/2$, 其有效磁矩(有效玻尔磁子数) $p_{eff}=g[s(s+1)]^{1/2}=5.92$, 式中 Mn^{++} 离子的 g 因子 $g=2$ 。在过渡族元素离子中, Mn^{++} 离子的有效磁矩最大。

稀土元素离子的磁性则由 $4f$ 壳层电子贡献。由于 $4f$ 壳层电子沉埋在原子壳层内部, 同时由于外层 $5s^2$ 、 $5p^6$ 电子的屏蔽, 故受晶场作用比过渡族元素离子小得多, 近似于单个离子的情况。稀土族元素离子的磁矩与总角动量量子数 J 有关。在大多数情况下, 稀土离子在晶体中以三价形式存在, 表 1 给出三价稀土元素离子的有效玻尔磁子数^[3] $p=g[J(J+1)]^{1/2}$ 。

有效玻尔磁子数的理论计算中 g 因子用 Lande 公式决定:

$$g=1+\frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)},$$

式中 J 、 S 、 L 分别为总角动量、自旋和轨道角动量量子数; 由洪德定则决定的基态有泡利原理所容许的最大重数 $2S+1$, 并具有与这一多重性相应的最大 L ; 当壳层少于半满填充时, $J=L-S$, 壳层电子大于半满时 $J=L+S$ 。例如, 对于 Sm^{3+} 离子, 有 $L=5$ 、 $S=5/2$ 、 $J=L-S=5/2$ 。从表中可见, 绝大多数稀土元素离子的有效玻尔磁子数实验值与理论值差别很小, 仅 Eu^{3+} 和 Sm^{3+} 离子的差别十分明显。对这些离子中如考虑到 $L-S$ 多重态的较高能态的影响(能级的间隔 $\Delta E < kT$), p 的确精计算值与实验值可以符合得相当好。从表中还可以看出 Sm^{3+} 的有效磁矩是稀土离子中最小的。

表 1 三价稀土离子的有效玻尔磁子数 p

Table 1 Effective Bohr magneton number p for trivalent rare-earth ions.

离 子	电 子 组 态	基 态	$p=g\sqrt{J(J+1)}$	p 的精确计算值	实 验 值
Ce ⁺⁺⁺	$4f^15s^25p^6$	$^2F_{5/2}$	2.54	2.56	2.4
Pr ⁺⁺⁺	$4f^25s^25p^6$	3H_4	3.58	3.62	3.6
Nd ⁺⁺⁺	$4f^35s^25p^6$	$^4I_{9/2}$	3.62	3.68	3.6
Pm ⁺⁺⁺	$4f^45s^25p^6$	5I_4	2.68	2.83	—
Sm ⁺⁺⁺	$4f^55s^25p^6$	$^6H_{5/2}$	0.82	1.6	1.5
Eu ⁺⁺⁺	$4f^65s^25p^6$	7F_0	0	3.5	3.6
Gd ⁺⁺⁺	$4f^75s^25p^6$	$^8S_{7/2}$	7.94	7.94	8.0
Tb ⁺⁺⁺	$4f^85s^25p^6$	7F_6	9.72	9.7	9.6
Dy ⁺⁺⁺	$4f^95s^25p^6$	$^6H_{15/2}$	10.63	10.6	10.6
Ho ⁺⁺⁺	$4f^{10}5s^25p^6$	5I_8	10.60	10.6	10.4
Er ⁺⁺⁺	$4f^{11}5s^25p^6$	$^4I_{15/2}$	9.59	9.6	9.4
Tm ⁺⁺⁺	$4f^{12}5s^25p^6$	3H_6	7.57	7.6	7.3
Yb ⁺⁺⁺	$4f^{13}5s^25p^6$	$^2F_{7/2}$	4.52	4.5	4.5

3 实验

Cd_{1-x}Sm_xTe 单晶样品用改进的 Bridgman 方法生长, 由中国科学院上海技术物理研究所提供, 标称组份分别为 $x=0.0005, 0.005, 0.01, 0.05$, 组份用电子探针、X光荧光法测定。样品表面为解理面或机械抛光后经化学腐蚀。光致发光谱用法国 Quantel 公司 DATACHROM-5000 型 YAG 二次谐波泵浦染料激光器(若丹明 B)产生, 激发光为 586 nm 的黄光, 脉冲重复频率为 10 次/s, 每个脉冲宽度为 10 ns, 谱线宽度为 0.016 nm, 能量为 15 mJ。光束聚焦在样品上, 荧光通过法国 HRD-1 型双光栅单色仪分光, 由 RCA 31034 型光电倍增管连接 162 Boxcar 积分器接收后记录, 并用光电管收集激光的杂散光作为 Boxcar 的同步触发信号。实验过程中样品置于温度可变的低温杜瓦瓶内。实验装置参见图 1。

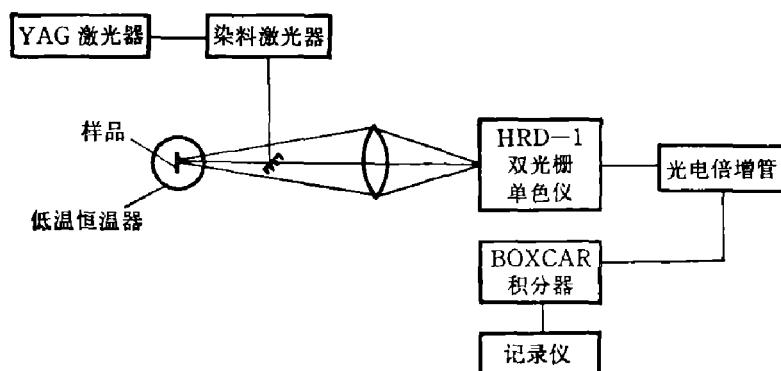


图 1 光致发光谱测量的实验装置

Fig. 1 Experimental set-up for photoluminescence spectroscopy measurements

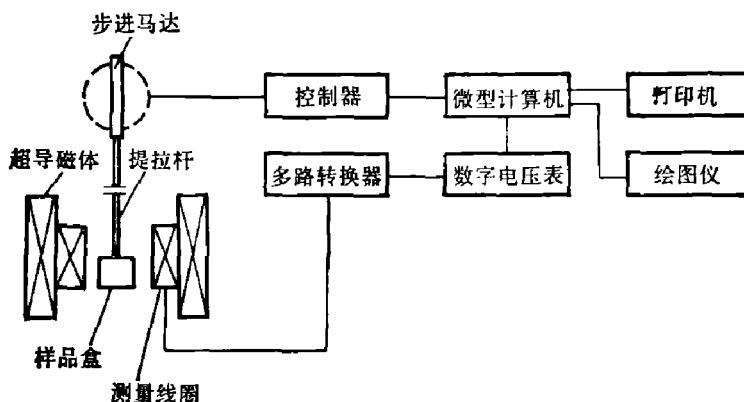


图 2 提拉法磁化强度测量设备装置方框图

Fig. 2 Block diagram of the experimental set-up with the extraction method for magnetization measurements

磁化强度的测量是通过提拉机构驱动提拉杆带动样品盒, 使样品在两个串联反接的线圈组的中心之间移动, 用接收器同步检测线圈中的感应信号。提拉法磁化强度测量装置方框图见图 2, 超导磁体的磁场强度从 0~7 T 连续变化, 测量在 1.5 K 下进行。测量全过程由微型计算机自动控制, 由打印机和绘图仪给出测量结果和相应曲线。

4 结果和讨论

4.1 Cd_{1-x}Sm_xTe 的光致发光光谱

图 3 给出液氮下光致发光谱的典型结果, 图中表明随着标称组份 x 的增加, Cd_{1-x}Sm_xTe 的发光峰值略向短波、高能方向移动, $x=0.0005, 0.005, 0.01$ 三个样品的光致发光谱峰值分别为 789、788、787 nm。这个变化趋势与晶格常数测量值随 x 的增加而减小的结果相对应。表 2 给出不同标称组份的 Cd_{1-x}Sm_xTe 晶格常数等参数^[4], 表中 x' 是电子探针测定的实际组份值。

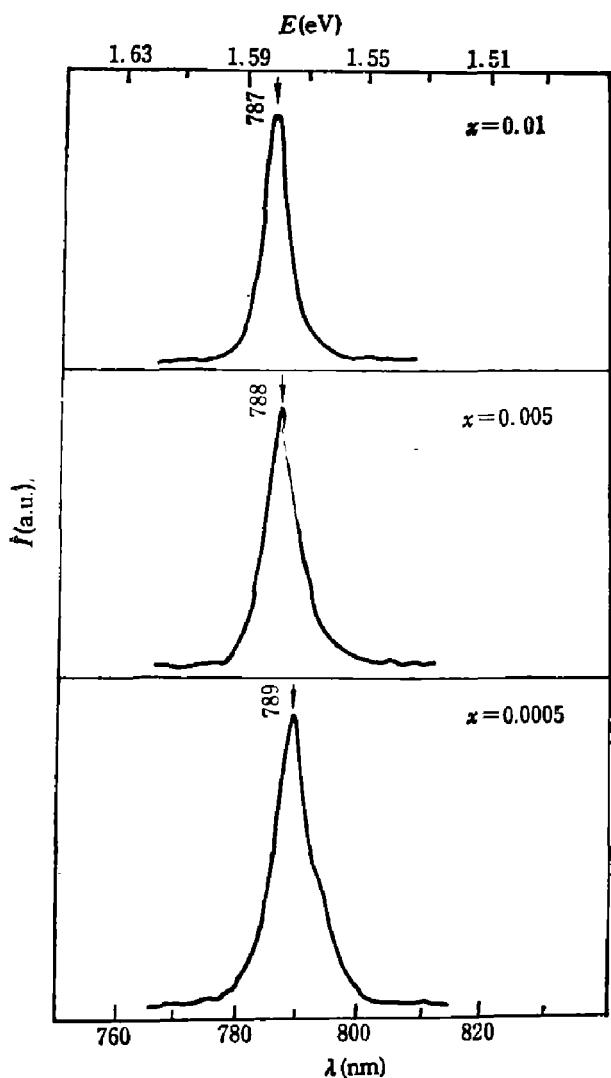


图 3 $T=80\text{ K}$ 时不同组份 Cd_{1-x}Sm_xTe 的光致发光谱

Fig. 3 Photoluminescence spectra for Cd_{1-x}Sm_xTe with different composition

大量实验表明, 三元 SMSO 化合物的晶体常数可由 Vegard 定律得到^[2]。例如, II-VI 族半导体的晶格参数为 $a_{\text{II-VI}}$, 以 Mn⁺⁺ 构成的 Mn-VI 磁性半导体的晶格参数为 $a_{\text{Mn-VI}}$, 则 SMSO II_{1-x}Mn_xVI 的晶格参数可表示为

$$\begin{aligned} a &= (1-x)a_{\text{II-VI}} + xa_{\text{Mn-VI}} \\ &= a_{\text{II-VI}} + (a_{\text{Mn-VI}} - a_{\text{II-VI}})x. \end{aligned}$$

对于含 Sm 离子三元化合物 Cd_{1-x}Sm_xTe, 已知 $a_{\text{CdTe}} = 6.48265$, $a_{\text{SmTe}} = 6.594$ ^[5], Sm 离子如果发生 Sm²⁺→Sm³⁺ 转变, 会使晶格常数发生变化。例如 Sm²⁺S→Sm³⁺S, 晶格参数减小, $a(\text{Sm}^{2+}) = 0.597\text{ nm} \rightarrow a(\text{Sm}^{3+}) = 0.561\text{ nm}$ 。实验观察到在 SmTe 中 Sm²⁺ 离子转变为 Sm³⁺ 离子时, 晶格常数亦随之减小。表 2 给出的晶格常数随 Sm 离子含量的增加而减小的趋势表明了 Sm³⁺ 离子在晶体中的主要作用。与能隙相联系的发光峰随 x 值增加向短波、高能方向的移动可能反映了 Cd_{1-x}Sm_xTe 能隙随 Sm³⁺ 离子组份的变化。电子探针测量结果表明: 标称组份 $x=0.01$ 的样品的实际组份仅为 0.14%, 而 $x=0.05$ 的样品的实际组份仅为 0.01(参见表 2)。这些实验表明 Sm 在 CdTe 晶体中的分凝系数很大, X 光发光的数据也给出了类似的结果。因而, 定量地分析能隙随 x 组份的变化和 Sm³⁺ 的作用尚有待进一步的研究。

4.2 Cd_{1-x}Sm_xTe 的磁化强度与磁场强度关系

用提拉法在 1.5 K 温度下测量了不同组份 Cd_{1-x}Sm_xTe 样品的磁化强度与磁场强度关系, 测量时超导磁体磁场强度高达 7 T。图 4 给出最大组分 $x=0.05$ 样品在 1.5 K 下磁化强

表 2 Cd_{1-x}Sm_xTe 的晶格常数和组份^[4]
Table 2 Lattice constant and composition for Cd_{1-x}Sm_xTe^[4]

x (标称组份)	a (nm) (晶格常数)	x' (电子探针测定组份值)
0.0005	0.648263	
0.005	0.64826	
0.01	0.64826	0.0014
0.05	0.64825	0.01 ^(a)

(a) 本文测量结果。

度随磁场强度变化的典型结果, 表现出极弱的顺磁性。这是由于稀土元素离子的有效磁矩与总角动量有关, 是4f壳层电子轨道磁矩和自旋磁矩之和, 而与过渡族元素3d壳层特性完全不同, 后者由于轨道角动量冻结, 有效磁矩只由3d电子自旋磁矩贡献。

稀土元素Sm($Z=62$)的Sm³⁺离子电子组态为 $4f^65s^25p^6$, 其基态为 7F_0 ($L=3$, $S=3$, $J=0$), 因而有效磁矩 $p=g[J(J+1)]^{1/2}=0$ 。Sm³⁺离子的有效磁矩是稀土元素离子中最小的(参见表1), 我们的实验结果与此分析结果一致。这种情况下稀土元素离子的宏观磁化强度正比于热平均的有效磁矩(轨道加自旋)。由于实际组份比标称组份小得多, 目前尚不能定量分析稀土离子Sm³⁺的电子与能带中迁移载流子的交换作用, 还有待于作进一步研究。如果要使含稀土元素的SMSO材料具有较大的有效磁矩, 可进一步研究含Dy³⁺和Gd³⁺等稀土离子的SMSO材料。

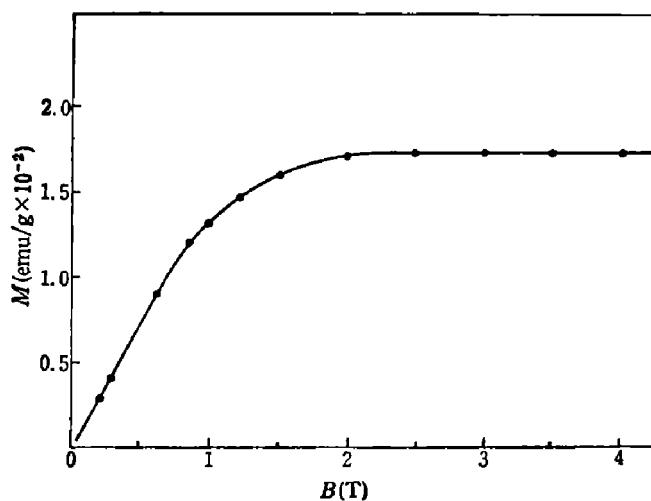


图 4 $T=1.5$ K 时 Cd_{0.95}Sm_{0.05}Te 磁化强度和磁场关系
Fig. 4 Magnetization vs magnetic field for Cd_{0.95}Sm_{0.05}Te at 1.5 K

5 结 论

首次探测了不同标称组份的 Cd_{1-x}Sm_xTe 晶体的光致发光和磁化强度, 结果表明, 随着组份 x 的增加, 与能隙相联系的发光峰移向短波(高能)方向, 这可能反映了能隙随 x 的变化, 并与晶格参数随着 x 增加变小趋势相对应。用提拉法在温度 1.5 K、磁场强度 0~7 T 范围内测量磁化强度与磁场强度的变化结果表明 Cd_{1-x}Sm_xTe 晶体中存在很弱的顺磁性, 其有效磁矩与总角动量相关。

参 考 文 献

- 1 陈辰嘉. 物理, 1988; **17**: 462
- 2 Furdyna J K. *J. Appl. Phys.*, 1988; **64**: R 29
- 3 方俊鑫, 陆栋. 固体物理学(下册). 上海: 上海科学技术出版社, 1981; 238
- 4 韩平, 马可军, 沈学础. 半导体学报, 待发表.
- 5 Jayaraman A et al. *Phys. Rev. Lett.*, 1970; **25**: 1430
- 6 Campagna M et al. *Phys. Rev. Lett.*, 1974; **33**: 166

STUDIES OF OPTICAL AND MAGNETIC PROPERTIES IN $\text{Cd}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Te}^*$

CHEN CHENJIA, QU MING, SHI SHOUXU, TANG XIAODONG

(Department of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

MA KEJUN

(Shanghai Institute of Technical Physics, Academia Sinica, Shanghai 200083, China)

$\text{Cd}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Te}$ crystals ($x=0.0005, 0.005, 0.01, 0.05$) have been grown by Bridgeman method for the first time. Photoluminescence measurements have been carried out in liquid nitrogen temperature range and the magnetization measurements have been made at 1.5 K and magnetic fields up to 7 T by using the extraction method. It is shown that the photoluminescence peak shifts toward the short wavelength (high energy) with the increase of x , corresponding to the decrease of lattice constant. The difference of paramagnetism between the rare-earth ions and transition metal ions is discussed and analyzed.

Key words: rare-earth ions, photoluminescence, magnetization, samarium cadmium telluride (CdSmTe).

* Project supported by the National Natural Science Fund of China.